



中国质谱学会第一届理事会 在京召开第四次会议

中国质谱学会第一届理事会第四次会议于1984年2月13至14日在京召开。到会理事共29人。

2月13日上午会议开幕,理事长张青莲教授主持了会议并致词。学会挂靠单位领导吴作力厂长到会看望并讲了话。付理事长兼秘书长向鹏举同志做了学会工作汇报。他首先介绍了1983年学会工作计划的执行情况:四个专业委员会分别召开了年会,参加年会人数288人,共交流了论文报告117篇;邀请了三位国外质谱学专家来华讲学;出版了四期《质谱学杂志》;组织编写了《2000年中国质谱学》。接着提出了1984年工作计划草案,主要有三项:①8月21至23日在北京举行《中日质谱学讨论会》②召开第二次会员代表大会暨第四次全国质谱学会议③继续出版四期《质谱学杂志》。最后汇报了中日质谱学讨论会的筹备情况。

付理事长邱纯一同志报告了会章的修改建议和二次会员代表大会代表及第二届理事候选的产生办法草案。付秘书长王世俊介绍了《2000年中国质谱学》的编写情况。

13日下午及14日上午,分组对上述内容进行了讨论。14日午再次举行了全体会议,最后通过了修改后的上述报告以及批准了240人加入质谱学会。(炳 襄)

第四届国际二次离子质谱学会议

第四届国际二次离子质谱学会议于1983年11月13日至19日在日本大阪举行,十八个国家和地区约二百五十位代表参加了会议,我国由清华大学查良镇同志和复旦大学朱昂如同志组团首次参加,查良镇付教授还应邀担任了一个专题会议的主席。

提交这次会议的论文共144篇,是历届会议中最多的一次。大会综述报告三篇:美国Cornell大学的G. H. Morrison教授在“二次离子质谱的图象处理”报告中就数据的采集、修正、分析和显示四个方面作了综述;西德Münster大学的A. Benninghoven教授作了“有机二次离子质谱学”的综述,介绍了SIMS在检测复杂有机分子方面的进展,指出目前可检测的质量数已达5,000 a.m.u以上,在仪器方面飞行时间质谱计的发展和应用引人注目,但有机二次离子的发射机理有待进一步研究;日本真空(ULVAC)的小宫宗治(S. Komiya)博士在“超高真空二次离子质谱学”报告中指出避免污染分析清洁表面的重要性,并介绍了他们研制的SIMS-AES复合表面分析仪器,讨论了对金属表面氧化和对半导体材料进行氢检测的一些研究结果,还介绍了UHV-SIMS有关的C_K⁺离子源和液态金属场发射离子源的最新研究成果。